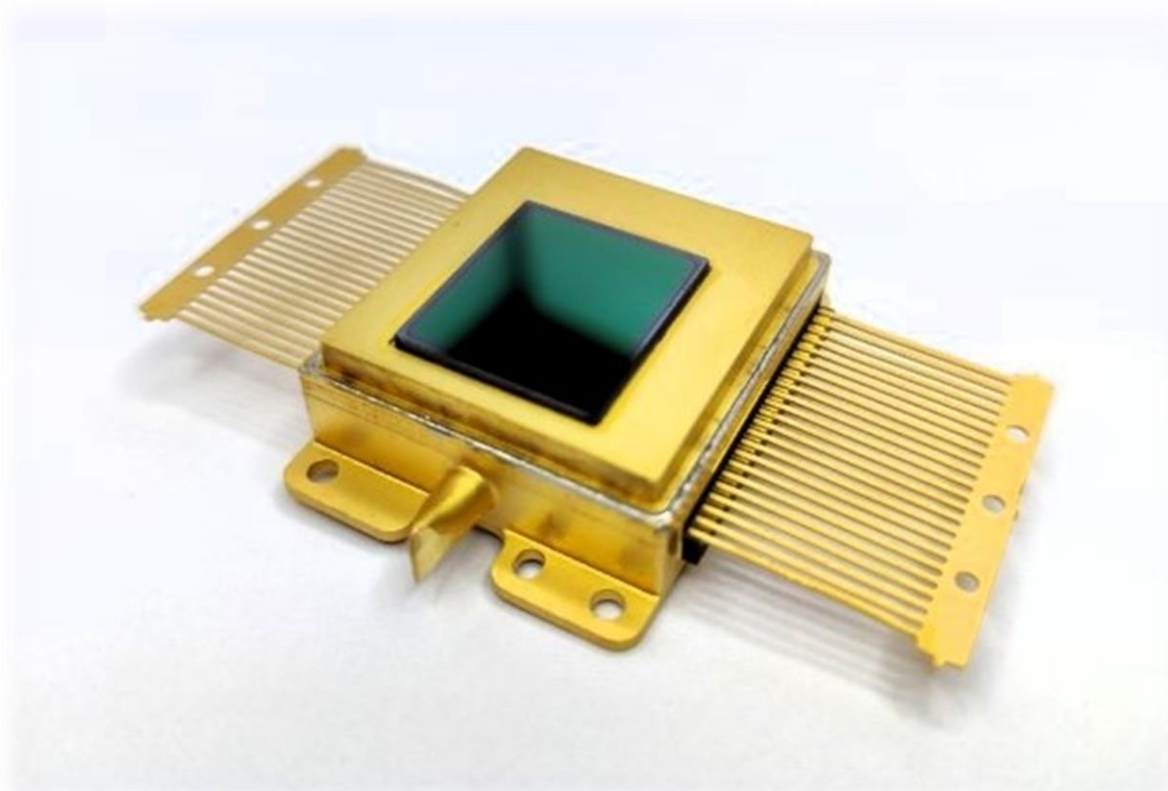


Istotny współudział przy opracowaniu technologii oraz wykonaniu pierwszej polskiej matrycy fotodetektorów na bazie supersieci II rodzaju InAs/GaSb o rozdzielczości 320x256 pikseli na zakres średniej podczerwienie chłodzonej termolektrycznie

do zastosowań w przemyśle oraz systemach naprowadzania rakiet



Miejsce wykonania: Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie.

Zdolność do obrazowania pierwszej matrycy potwierdziliśmy 26.10.2023 r.